

# 深圳市明微电子股份有限公司

#### SHENZHEN SUNMOON MICROELETRONICS CO.,LTD

地址:深圳市高新技术产业园南区高新南一道国微大厦5楼

ADD: Shenzhen High-tech Industrial Park, South Area Gaoxin S. Ave. 1st , Guowei Building.

电话 Tel: 0755-26991391 传真 Fax: 0755-26991336 邮编: 518057

网址: www.chinaasic.com 电子邮箱 Email:sunmoon@ssmec.com

SM74HC595D

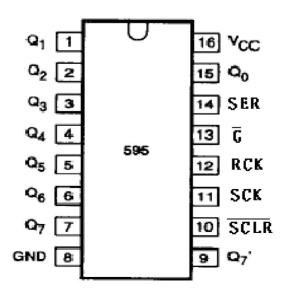
#### 一、简述

SM74HC595D 是一种具有 8 位锁存、8 位串行输入、 8 位串/并行输出、 串—并移位寄存器和三态输出功能的通用 LED 驱动芯片。具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在 SCK 的上升沿输入,在 RCK 的上升沿进入的存储寄存器中去。移位寄存器有一个串行移位输入(SER),和一个串行输出(Q7'),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能时G(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。它可以与其他公司生产的74HC595 完全兼容。

#### 二、功能特点:

- 具有8位串行输入;
- 具有 8 位串行和并行输出;
- 具有移位寄存器直接清"零"功能:
- 具有锁存与3 态输出功能:
- 能通过 50MHz 移位时钟;
- 工作电压: 2V—6V

### 三、脚位图



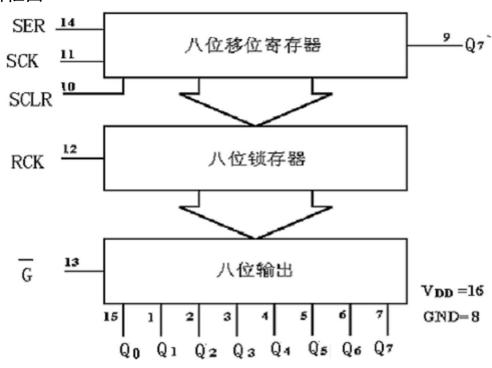
# 四、管脚功能定义

管脚序号	符号	管脚功能							
10	SCLR	复位端							
11	SCK	移位寄存器时钟,上升沿移位							
12	RCK	锁存寄存器时钟,上升沿存储							
13	G	输出使能端,为低电平使,输出选通;为高电 平时,输出为3态							
14	SER	串行数据输入端							
15、17	Q0Q7	并行输出端							
9	Q7`	串行输出							
8	GND	逻辑地							
16	$V_{CC}$	电源端							

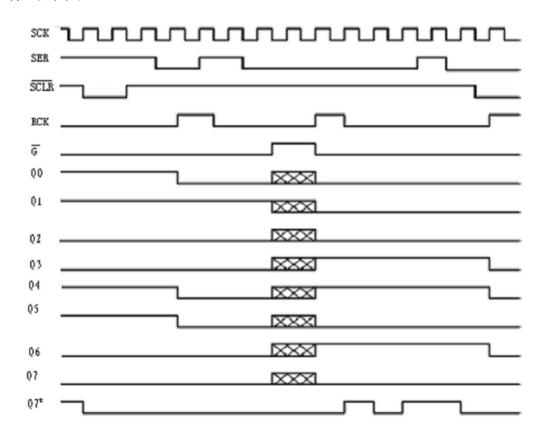
# 五、功能真值表

RCK	SCK	SCLR	G	功能
X	X	X	Н	Q0Q7 为 3 态、
X	X	L	L	移位寄存器清"零", Q7`=0
X	1	Н	L	移位寄存器存储, Q <sub>N</sub> =Q <sub>N-1</sub> , Q <sub>A</sub> =SER
<b>↑</b>	X	Н	L	存储移位寄存器的值

## 六、逻辑框图



## 七、工作时序图



# 八、直流电气特性

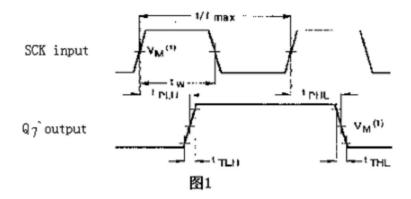
符号	参数	 条件	VCC	$T=25^{0}$	单位
				典型值	
$V_{ m IH}$	输入高电平最		2.0V	1.5	
	低电压		4.5V	3.15	
			6.0V	4.2	
$ m V_{IL}$	输入低电平最		2.0 V	0.5	V
	高电压		4.5V	1.35	
			6.0V	1.8	
$ m V_{OH}$	输出高电平最	$V_{IV}=V_{IH}$ or $V_{IL}$	2.0V	1.9	
	小值	$ I_{OUT}  \leq 20 \text{ uA}$	4.5V	4.4	
			6.0V	5.9	
	Q7`	$V_{IV}=V_{IH}$ or $V_{IL}$	4.5V	3.84	
		$ I_{OUT}  \leq 4.0 \text{ mA}$	6.0V	5.34	
		$ I_{OUT}  \leq 5.2 \text{ mA}$			
	Q0Q7	$V_{IV}=V_{IH}$ or $V_{IL}$	4.5V	3.84	
		$ I_{OUT}  \leq 6.0 \text{ mA}$	6.0V	5.34	
		$ I_{OUT}  \leq 8.2 \text{ mA}$			
$V_{OL}$	输出低电平最	V <sub>IV</sub> =V <sub>IH</sub> or V <sub>IL</sub>	2.0V	0.1	17
	大值	$ I_{OUT}  \leq 20 \text{ uA}$	4.5V	0.1	V
	, , ,	,,	6.0V	0.1	
	Q7`	$V_{IV}=V_{IH}$ or $V_{IL}$	4.5V	0.33	
		$ I_{OUT}  \leq 4.0 \text{ mA}$	6.0V	0.33	
		$ I_{OUT}  \leq 5.2 \text{ mA}$			V
	Q0Q7	V <sub>IV</sub> =V <sub>IH</sub> or V <sub>IL</sub>	4.5V	0.33	
		$ I_{OUT}  \leq 6.0 \text{ mA}$	6.0V	0.33	
		$ I_{OUT}  \leq 7.8 \text{ mA}$			
$I_{IN}$	最大输入电流	V <sub>IN</sub> =VCC or GND	6.0V	±1.0	uA
$I_{OZ}$	最大3态输出	V <sub>out</sub> =VCC or GND	6.0V	±5.0	uA
-	漏电流	$\overline{G}=V_{IH}$			
$I_{CC}$	最大静态电流	V <sub>out</sub> =VCC or GND	6.0V	80	uA
		$I_{OUT}=0 uA$			

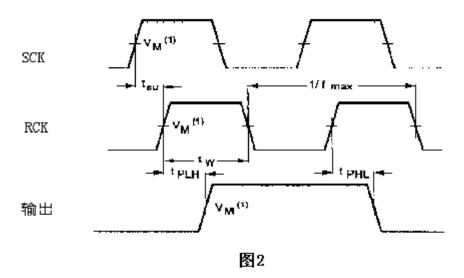
# 九、交流电气特性

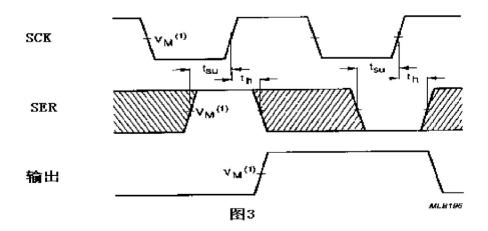
GND=0,  $T_r$ = $T_f$ =6ns,  $C_L$ =50 PF VCC=4.5V

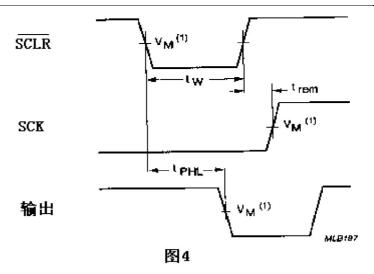
<i>k</i> ⁄c □	42 W.		T 温度	34	AP IIV IEI		
符号	参数		+25 <sup>0</sup>	单	波形图		
		最小	典型	最大	位		
$t_{\mathrm{PHI}}/t_{\mathrm{PLH}}$	移位时钟有效沿到 Q7 输出的延迟		15	22		图 1	
$t_{\mathrm{PHI}}/t_{\mathrm{PLH}}$	存储时钟有效沿到输出的延迟		16	22		图 2	
$t_{ m PHL}$	复位有效沿到 Q7 输出的延迟		20	40		图 4	
$t_{\mathrm{PZH}}/t_{\mathrm{PZL}}$	3 态允许信号有效沿到输出的时间		21	35		图 5	
$t_{\mathrm{PZH}}/t_{\mathrm{PZL}}$	3 态禁止信号有效沿到输出的时间		18	30	ns	图 5	
$t_{ m W}$	移位时钟宽度	10	20		113	图 1	
$t_{ m W}$	存储时钟宽度	10	20	_		图 2	
$t_{ m W}$	复位时间宽度	15	25			图 4	
${ m t_{SU}}$	存储的数据建立时间	16	25			图 3	
$t_{ m SU}$	移位的数据建立时间	16	25			图 2	
$t_h$	数据保持时间	3	12			图 3	
$t_{\rm rem}$	复位到移位时钟的时间	10	17			图 4	
$f_{max}$	最大时钟频率 RCK 或 SCK	30	52	_	MHz	图 1、2	

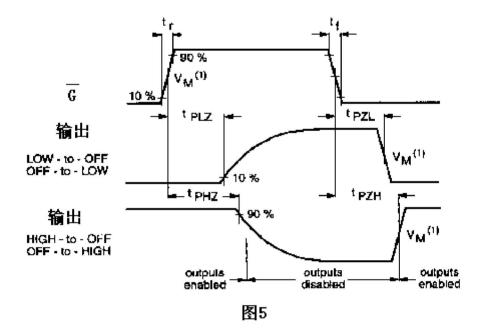
# 十、交流特性波形图



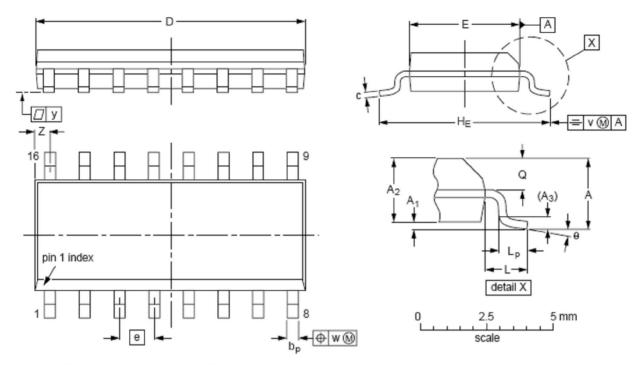








## 十一、封装示意图



DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A max.	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	b <sub>p</sub>	С	D <sup>(1)</sup>	E <sup>(1)</sup>	e	HE	L	L <sub>p</sub>	Q	V	w	у	Z <sup>(1)</sup>	6
mm	1.75	0.25 0.10	1.45 1.25	0.25	0.49 0.36	0.25 0.19	10.0 9.8	4.0 3.8	1.27	6.2 5.8	1.05	1.0 0.4	0.7 0.6	0.25	0.25	0.1	0.7 0.3	8°
inches	0.069	0.010 0.004		0.01	0.019 0.014	0.0100 0.0075	0.39 0.38	0.16 0.15	0.050	D.244 D.228	0.041	0.039 0.016	0.028 0.020	0.01	0.01	0.004	0.028 0.012	0°